

シリコンNPN三重拡散メサ形トランジスタ
SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR

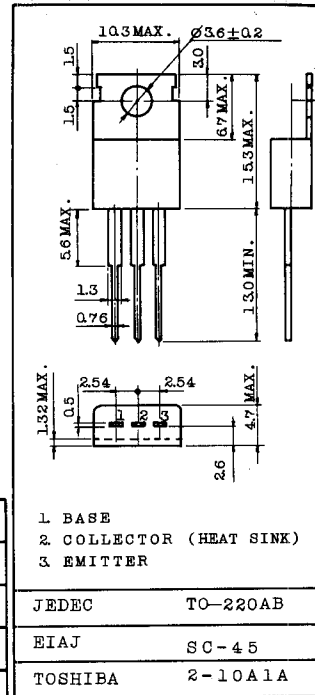
2SC1669

- 低周波電力増幅用
- 励振段電力増幅用
 - Audio Power Amplifier Applications
 - Driver Stage Amplifier Applications
- 高耐圧です: $V_{CEO} = 150V$
- 出力 Hi - Fi Amp の励振段に適します。
- 2SA839 とコンプリメンタリになります。
- Complementary to 2SA839

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	150	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	150	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	1.5	A
エミッタ電流	I_E	-1.5	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ C$)	P_C	25	W
接合 温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ 150	$^\circ C$

Unit in mm



アクセサリは AC75 を適用
MOUNTING KIT No. AC75

2SC1669

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C)

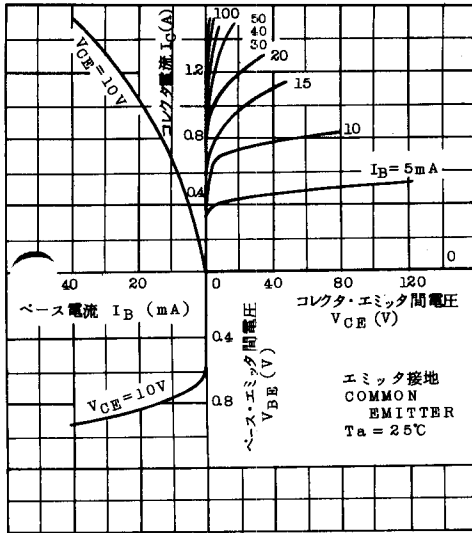
CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=100V, I_E=0$	-	-	20	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5V, I_C=0$	-	-	10	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=10mA, I_B=0$	150	-	-	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=1mA, I_C=0$	5	-	-	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ Note	$V_{CE}=10V, I_C=0.5A$	40	-	240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=10V, I_C=1A$	20	-	-	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500mA, I_B=50mA$	-	-	1.5	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE}=10V, I_C=0.5A$	0.65	-	0.85	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=10V, I_E=-0.5A$	-	6	-	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0,$ $f = 1MHz$	-	30	-	pF

Note : $h_{FE(1)}$ により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of $h_{FE(1)}$, the 2SC1669 is classified as follows.

CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SC1669-R	40	80
2SC1669-O	70	140
2SC1669-Y	120	240

STATIC CHARACTERISTICS



$I_C - V_{CE}$ (LOW VOLTAGE REGION)

